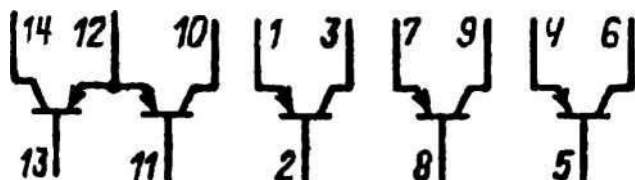


К198НТ5А, К198НТ5Б, КР198НТ5А, КР198НТ5Б, КБ198НТ5-4

Микросхемы представляют собой матрицу р-п-р транзисторов. Содержат 5 интегральных элементов. Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,8 г и типа 201.14-1, масса не более 1 г.



Электрическая схема КР198НТ5

Назначение выводов: 1 — эмиттер транзистора VT3; 2 — база VT3; 3 — коллектор VT3; 4 — эмиттер VT5; 5 — база VT5; 6 — коллектор VT5; 7 — эмиттер VT4; 8 — база VT4; 9 — коллектор VT4; 10 — коллектор VT2; 11 — база VT2; 12 — эмиттеры VT1 и VT2; 13 — база VT1; 14 — коллектор VT1.

Электрические параметры

Напряжение насыщения база - эмиттер	≤ 1 В
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер	≤ 1 В
Напряжение смещения нуля дифференциальной пары	≤ 4 мВ
Обратный ток коллектора	≤ 0,3 мкА
Статический коэффициент передачи тока:	
К198НТ5А, КР198НТ5А	20... 125
К198НТ5Б, КР198НТ5Б	60...300
Разброс коэффициента передачи тока дифференциальной пары ...	≤ 15%

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор – база	20 В
Напряжение эмиттер – база	5 В
Ток коллектора	10 мА
Рассеиваемая мощность одним транзистором	20 мВт
Температура окружающей среды	-45...+85 °С